



《风光欣》技术资料

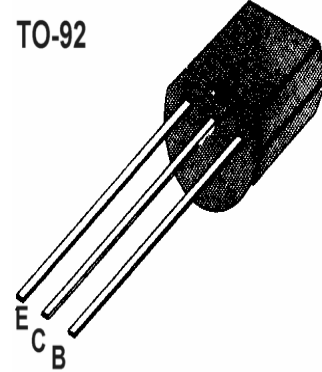
A1015

PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR

主要用途:音频通用放大、驱动等。

绝对最大额定值 (Ta=25)

项 目	符号	额定值	单位
集电极-基极电压	V _{CB0}	-50	V
集电极-发射极电压	V _{CEO}	-50	V
发射极-基极电压	V _{EBO}	-5	V
集电极电流	I _c	-150	mA
基极电流	I _B	-50	mA
集电极耗散功率	P _c	400	mW
结 温	T _J	125	
存储温度	T _{STG}	-65 ~150	



电参数 (Ta=25)

项 目	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	BV _{CB0}	I _c = -100 μ A, I _E = 0	-50			V
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	I _c = -10mA, I _B = 0	-50			V
发射极-基极击穿电压	BV _{EBO}	I _E = -10 μ A, I _C = 0	-5			V
集电极-基极截止电流	I _{CB0}	V _{CB} = -50V, I _E =0			-0.1	μ A
发射极-基极截止电流	I _{EBO}	V _{EB} = -5V, I _C =0			-0.1	μ A
直流电流增益	h _{FE}	V _{CE} = -6V, I _c = -2mA	70		400	
集电极-发射极饱和压降	V _{CE(sat)}	I _c = -100mA, I _B = -10mA		-0.1	-0.3	V
基极-发射极饱和压降	V _{BE(sat)}	I _c = -100mA, I _B = -10mA			-1.1	V
电流增益-带宽乘积	f _T	V _{CE} = -10V, I _c = 1mA	80			MHZ
共基极输出电容	C _{OB f=1MHZ}	V _{CB} = -10V, I _E =0,		4.0	7.0	pF
噪声系数	NF	V _{CE} = -6V, I _c = -0.1mA F=100HZ, R _G =10K		0.5	6.0	dB

Hfe 分档及其标志

分档	O	Y	G
H _{FE}	70-140	120-240	200-400